

3rd Atomic Layer Process (ALP) Workshop

日時：2017年6月23日（金）午後1時 - 6時

場所：東京大学工学部4号館3階42号教室（419号室）（本郷キャンパス） 東京都文京区本郷 7-3-1

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_05_j.html

会議主旨：Atomic Layer Etching および Plasma-Assisted Atomic Layer Deposition 技術の基礎
理解し、ガス・材料・プラズマ等の幅広い分野の研究者・技術者が同技術の問
題意識を

共有することにより、この分野の更なる技術革新を推進することを目的とする

。

参加ご希望の方は、事前のご登録をよろしくお願いいたします。

事前登録連絡先：唐橋一浩（karahashi@ppl.eng.osaka-u.ac.jp）

プログラム概要

13:00-13:10 浜口智志（大阪大）： 開会のご挨拶：趣旨説明
1 13:10-13:50 唐橋一浩（大阪大） "ビーム実験によるエッチング反応解析"
2 13:50-14:30 豊田紀章（兵庫県立大） "ガスクラスターイオンビーム励起表面反応と原子層エッチングへの応用"
3 14:30 - 15:10 篠田和典（日立製作所） "プラズマを用いた窒化膜の原子層レベルエッチング"
break 15:10-15:30
4 15:30-16:10 大場富人（LAMリサーチ） "Ga ₂ O ₃ およびAlGa ₂ O ₃ の異方性ALE"
5 16:10-16:50 小林伸好（日本ASM） "7nm以降に向けた絶縁膜の原子層プロセス"
6 16:50 - 17:30 大下祥雄（豊田工大） 町田英明（気相成長（株）） "GaAsN結晶中N-H欠陥の重水素化原料を用いた解析"
7 17:30-17:50 総合討論
17:50- 18:00 浜口智志（大阪大）： 閉会のご挨拶
懇親会（希望者のみ：会費制:要予約） 会場：東京大学工学部4号館43号教室 会費：2000円